Каталог продукции

Ослабление, детектирование и контроль РЧ-мощности

Проектирование трактов ослабления, детектирования и контроля по задаче регулирования, форме сигнала, динамике, быстродействию, направленной выборке, мощности и калибровке.



Продукция: 41

Редакция: 17 · Дата редакции: 2026-11-12

RF ограничители



LCI-LIM-12000-18000-PIP43MAX

12000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое) / 0.7 dB (максимальное); Уровень ограничения: 16.5 dBm (типовое) / 17.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 43 dBm (максимальное) (τ = 1 ms; D = 20%). Размеры кристалла: 1.4 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 12000; Максимум: 18000; Значение: 12000–18000; Единица: MHz

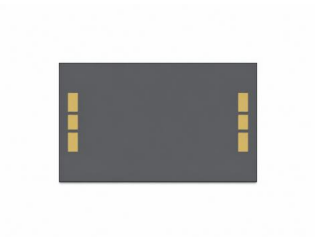
Вносимые потери: Типовое: 0.6; Максимум: 0.7; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4

Выходной КСВН: Типовое: 1.4

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-5000-6000

5000–6000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.45 dB (типовое) / 0.5 dB (максимальное); Уровень ограничения: 18.5 dBm (типовое) / 19.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 49 dBm (максимальное) (τ = 2 ms; D = 20%); Максимальная импульсная входная мощность: 50 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.45; Максимум: 0.5; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP42MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.5 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 42 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2 × 1.2 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

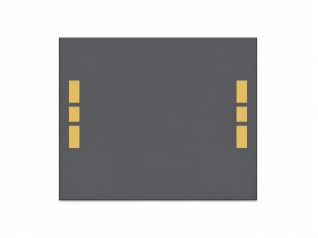
Вносимые потери: Типовое: 0.5; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-2000-6000-PIP43MAX

2000–6000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.3 dB (типовое) / 0.4 dB (максимальное); Уровень ограничения: 15 dBm (типовое) / 16 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 43 dBm (максимальное) (τ = 200 µs; D = 20%). Размеры кристалла: 1.8 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

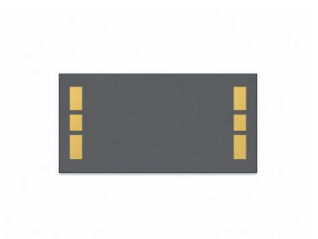
Вносимые потери: Типовое: 0.3; Максимум: 0.4; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4

Выходной КСВН: Типовое: 1.4

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-6000-18000-PIP42MAX

6000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 16.5 dBm (типовое) / 17.5 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 42 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.8 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

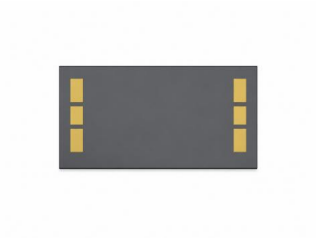
Вносимые потери: Типовое: 0.8; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.6

Выходной КСВН: Типовое: 1.6

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-6000-18000-PIP41MAX

6000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 41 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.6; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.5

Выходной КСВН: Типовое: 1.5

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP48MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 48 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%); Максимальная входная мощность: 46 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 1.85 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.8; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.5

Выходной КСВН: Типовое: 1.5

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-DC-14000-PICW37MAX

DC–14000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.4 dB (типовое) / 0.5 dB (максимальное); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная входная мощность: 37 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 1.25 × 0.65 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 14000; Значение: DC–14000; Единица: MHz

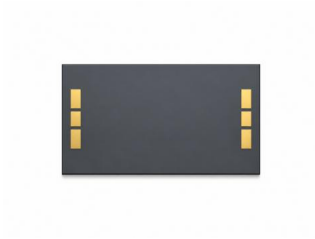
Вносимые потери: Типовое: 0.4; Максимум: 0.5; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP45MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.6 dB (типовое) / 0.7 dB (максимальное); Уровень ограничения: 15 dBm (типовое) / 16 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2 × 1.1 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.6; Максимум: 0.7; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.6

Выходной КСВН: Типовое: 1.6

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.3 dB (типовое); Уровень ограничения: 17 dBm (типовое) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 37 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.3; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP37MAX-M

8000–12000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.3 dB (типовое); Уровень ограничения: 17 dBm (типовое) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 37 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.9 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.3; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.2; Максимум: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-10000-18000-PIP45MAX

10000–18000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения: 17 dBm (типовое) / 18 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) (τ = 200 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 1.6 × 0.85 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 10000; Максимум: 18000; Значение: 10000–18000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.8; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.6; Максимум: 1.8

Выходной КСВН: Типовое: 1.6; Максимум: 1.8

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-DC-6000-PIP45MAX

DC–6000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.35 dB (типовое) / 0.4 dB (максимальное); Уровень ограничения: 15 dBm (типовое) / 16 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 45 dBm (максимальное) (τ = 300 µs; D = 30%). Размеры кристалла: 2.1 × 1.25 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 6000; Значение: DC–6000; Единица: MHz

Вносимые потери: Типовое: 0.35; Максимум: 0.4; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.4; Максимум: 1.5

Выходной КСВН: Типовое: 1.4; Максимум: 1.5

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-2000-4000-PIP51MAX

2000–4000 MHz Бескорпусной RF-ограничитель GaAs PIN

Вносимые потери: 0.4 dB (типовое); Уровень ограничения: 16 dBm (типовое) / 17 dBm (максимальное); Максимальная импульсная входная мощность: 51 dBm (максимальное) (τ = 100 µs; D = 10%); Максимальная входная мощность: 48 dBm (максимальное) (CW). Размеры кристалла: 2.6 × 1.5 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 2000; Максимум: 4000; Значение: 2000–4000; Единица: MHz

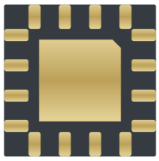
Вносимые потери: Типовое: 0.4; Единица: dB

Входной КСВН: Типовое: 1.3

Выходной КСВН: Типовое: 1.3

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-12000-18000-PIP43U

12000–18000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 43 dBm; PW = 1 ms; D = 20%

12000–18000 MHz; Вносимые потери 1.2 dB (типовое); Уровень ограничения 16 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 43 dBm; PW = 1 ms; D = 20%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 12000; Максимум: 18000; Значение: 12000–18000; Единица: MHz

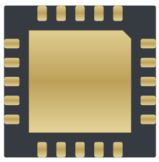
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 1.2; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 16; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 43 (PW = 1 ms; D = 20%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-5000-6000-PIP49U

5000–6000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%

5000–6000 MHz; Вносимые потери 0.9 dB (типовое); Уровень ограничения 15 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 49 dBm; PW = 2 ms; D = 20%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 5000; Максимум: 6000; Значение: 5000–6000; Единица: MHz

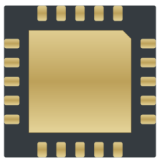
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 0.9; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 15; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 49 (PW = 2 ms; D = 20%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP42U

8000–12000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%

8000–12000 MHz; Вносимые потери 0.9 dB (типовое); Уровень ограничения 14 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 42 dBm; PW = 4 ms; D = 20%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

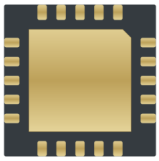
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 0.9; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 14; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 42 (PW = 4 ms; D = 20%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-2000-6000-PIP43U

2000–6000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 43 dBm; PW = 200 µs; D = 20%

2000–6000 MHz; Вносимые потери 0.6 dB (типовое); Уровень ограничения 15 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 43 dBm; PW = 200 µs; D = 20%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 2000; Максимум: 6000; Значение: 2000–6000; Единица: MHz

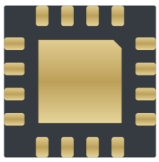
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 0.6; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 15; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 43 (PW = 200 µs; D = 20%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-6000-18000-PIP42U

6000–18000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 42 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

6000–18000 MHz; Вносимые потери 1.3 dB (типовое); Уровень ограничения 17 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 42 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

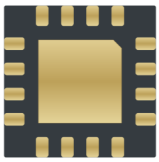
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 1.3; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 17; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 42 (PW = 300 µs; D = 30%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-6000-18000-PIP41U

6000–18000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 41 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

6000–18000 MHz; Вносимые потери 1.2 dB (типовое); Уровень ограничения 17 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 41 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 6000; Максимум: 18000; Значение: 6000–18000; Единица: MHz

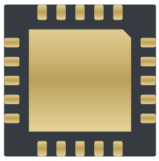
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 1.2; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 17; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 41 (PW = 300 µs; D = 30%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP48U

8000–12000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 48 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

8000–12000 MHz; Вносимые потери 1.2 dB (типовое); Уровень ограничения 16 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 48 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

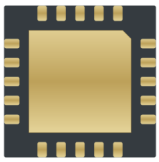
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 1.2; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 16; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 48 (PW = 300 µs; D = 30%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-8000-12000-PIP45U

8000–12000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

8000–12000 MHz; Вносимые потери 1 dB (типовое); Уровень ограничения 15 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 8000; Максимум: 12000; Значение: 8000–12000; Единица: MHz

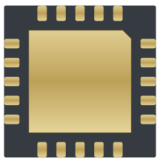
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 1; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 15; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 45 (PW = 300 µs; D = 30%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-1000-6000-PICW46U

1000–6000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 46 dBm; CW

1000–6000 MHz; Вносимые потери 0.8 dB (типовое); Уровень ограничения 16 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 46 dBm; CW.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 1000; Максимум: 6000; Значение: 1000–6000; Единица: MHz

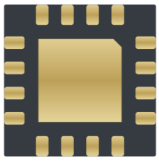
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 0.8; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 16; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 46 (CW); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-10000-18000-PIP45U

10000–18000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%

10000–18000 MHz; Вносимые потери 1.4 dB (типовое); Уровень ограничения 17 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 45 dBm; PW = 200 µs; D = 30%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: 10000; Максимум: 18000; Значение: 10000–18000; Единица: MHz

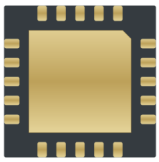
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 1.4; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 17; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 45 (PW = 200 µs; D = 30%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-DC-6000-PIP45U

DC–6000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%

DC–6000 MHz; Вносимые потери 0.65 dB (типовое); Уровень ограничения 15 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 45 dBm; PW = 300 µs; D = 30%.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: DC; Максимум: 6000; Значение: DC–6000; Единица: MHz

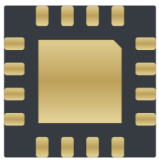
Вносимые потери: Обозначение: IL; Типовое: 0.65; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 15; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Значение: 45 (PW = 300 µs; D = 30%); Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCI-LIM-DC-14000-PICW37T

DC–14000 MHz GaAs Ограничитель RF в корпусе — Pp 37 dBm; CW

DC–14000 MHz; Вносимые потери 0.5 dB (типовое); Уровень ограничения 15 dBm (типовое); Допустимая входная мощность 37 dBm (типовое); CW.

Рабочая частота: Обозначение: f; Минимум: DC; Максимум: 14000; Значение: DC–14000; Единица: MHz

Вносимые потери: Обозначение: IL; Минимум: 0.1; Типовое: 0.5; Максимум: 0.65; Единица: dB

Уровень ограничения: Обозначение: PLim; Типовое: 15; Единица: dBm

Допустимая входная мощность: Обозначение: Pp; Типовое: 37; Значение: CW; Единица: dBm

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Фиксированные аттенюаторы



LCATT-DC-30000-A0-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.2 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.2

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A4

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 4 dB

Ослабление: 4 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 4; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p35X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A16

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 16 dB

Ослабление: 16 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.35 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 16; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A0-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 0 dB

Ослабление: 0 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.6 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 0; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.6; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A1-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 1 dB

Ослабление: 1 dB; Входной/выходной КСВН: 1.4 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 1; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.4

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A2-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 2 dB

Ослабление: 2 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 2; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A3-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 3 dB

Ослабление: 3 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 3; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A5

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 5 dB

Ослабление: 5 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 5; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A6

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 6 dB

Ослабление: 6 dB; Входной/выходной КСВН: 1.35 ; Неравномерность ослабления: ±0.4 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 6; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.35

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.4; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A8-S0p5X0p35

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 8 dB

Ослабление: 8 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.3 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 8; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.3; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия



LCATT-DC-30000-A10

DC–30000 MHz Кристалл фиксированного аттенюатора GaAs IPD, 10 dB

Ослабление: 10 dB; Входной/выходной КСВН: 1.3 ; Неравномерность ослабления: ±0.5 dB. Размеры кристалла: 0.5 × 0.35 × 0.1 mm.

Рабочая частота: Минимум: 0; Максимум: 30000; Значение: DC–30000; Единица: MHz

Ослабление: Значение: 10; Единица: dB

Входной/выходной КСВН: Значение: 1.3

Неравномерность ослабления: Значение: ±0.5; Единица: dB

TA = +25 °C

Подробнее о продукте Техническое описание изделия

Примечание к документу

Технические характеристики могут пересматриваться. До фиксации проекта подтвердите в LCRF актуальную редакцию документа и требования к конкретному изделию. Поставляемая конфигурация определяется утвержденным предложением и документацией заказа.